## 基于线性频率调制与解调的片上直流电压信号放大器<sup>\*</sup>

马 卓,潘国腾,郭 阳,谢伦国 (国际科技大学计算机学院,湖南长沙 410073)

摘 要: 片内直流电压信号摆幅较小,且受到 CMOS 工艺中被动器件一致性较差、易被高频交流信号干 扰等因素的影响,采用典型的比例放大电路难以放大这类信号。为此提出了一种基于"载频"的"电压→频率 →电压"放大方法,使用载波信号作为片上长距离传输的信号,将易受到干扰的直流信号局部化,利用前馈补 偿技术构建了具有高度线性转换关系的"电压→频率"调制电路,采用具有较高线性度的频率解调电路实现 后级电压信号的解调,有效地放大片内直流电压信号。电路仿真结果表明,所提出的放大器电路能有效地放 大片上电压信号,直流电压增益为2.4。

关键词:片内直流电压信号;放大器;线性;频率调制;解调

中图分类号:TN432 文献标志码:A 文章编号:1001-2486(2012)03-0136-06

# An on-chip DC Signal Amplifier based on linear frequency modulation and demodulation

MA Zhuo, PAN Guoteng, GUO Yang, XIE Lunguo

(College of Computer, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

**Abstract**: To amplify the DC signal is a discommodious issue, because of the on-chip DC signal has such properties as little swing, less coherence and likeliness to be interfered. In light of this, a "voltage-frequency-voltage" mode DC signal amplifier is proposed, in which the frequency is the carrier signal. This amplifier is highly linear, and is equipped with a high linearity "voltage-frequency" modulator and a "frequency-voltage" de-modulator. The simulation experimental results show that the DC signal amplifier amplifies the input voltage signal efficiently while achieving stable high linearity, and the DC gain is 2.4.

Key words: on-Chip DC signal amplifier; linearity; frequency modulation; demodulation

受到输出路径上的干扰及片内传输路径上的 损耗,片内直流电压信号的放大输出问题一直是 芯片测试中的难点。在典型的直流信号采集电路 中,比例电压放大是一种十分常见的方式,图 1 中给 出了一种典型的利用运算放大器(Operational Amplifier,OPA)进行直流电压放大的电路,利用 OPA 输入端"虚短(imaginary short)"的特性,闭环 系统能够保证 A 点的电压和待放大信号  $V_{in}$ 保持 一致,输出电压与待采样信号  $V_{in}$ 满足确定性的比 例<sup>[1]</sup>,表达式给出了在基于运放的电压比例电路 中的基本运算规则,其中  $V_{in}$ 为待放大信号, $V_{out}$ 为 放大输出的电压信号, $R_0$ 和  $R_1$ 为比例分压电阻 的阻值。

$$V_{\rm out} = (1 + \frac{R_0}{R_1}) \cdot V_{\rm in}$$
 (1)

但是,Lam、Chen研究了这种结构对于输入电 压信号的动态跟踪能力,指出了这种类LDO(Low



图 1 基于运放的比例电压放大电路结构 Fig. 1 The typical prootional amplifier for DC voltage signal

Dropout Regulator)形式的电压放大器的跟踪能力 十分有限<sup>[9-10]</sup>。Mohaned 和 Xu 进一步指出这种 结构对电源噪声的敏感程度<sup>[11-12]</sup>。针对这个问 题,本文提出了一种"电压→频率→电压"的放大 模式,并设计了具有极高线性度的"电压 – 频率" 调制与"频率 – 电压"解调电路,实现片内直流电 压信号的有效放大输出。信号放大过程被有效分 解为调制与解调两个步骤,能有效控制信号增益; 将易受干扰的直流信号有效地局部化,长距离传输使用交流信号作为"载波",提高了放大过程的抗干扰能力;"调制"与"解调"过程均具有高线性度的转换关系,极大地提高了整体放大电路的线性化程度。

## 基于频率调制与解调的电压信号放大 模型

对于直流电压信号放大而言,所实现的目的 就是将待放大信号乘以一定的系数,并驱动相应 的负载,这个关系如式(2)所示,其中k为比例系 数, $V_{in}$ 和 $V_{out}$ 分别为待放大电压和放大后的电压 信号。对应图1中的结构,式(1)中该比例系数 由分压电阻 $R_0$ 和 $R_1$ 的阻值确定。

$$V_{\rm out} = k \cdot V_{\rm in} \tag{2}$$

令比例系数 k = k<sub>1</sub> · k<sub>2</sub> · ··· · k<sub>n</sub>,则式(2)可 改写为式(3)的形式。

$$V_{out} = k_1 \cdot k_2 \cdots k_n \cdot V_{in} \tag{3}$$

考虑式(3)的可实现性,定义如图 2 的传输 系统,将比例系数 k 分解为三级比例系数,其中  $k_1,k_2,k_3$  为各级的比例系数。三级开环传递函数 如式(4)或(5)所示。

$$u_o = k_3 \cdot u_e = k_3 \cdot k_2 \cdot u_c = k_3 \cdot k_2 \cdot k_1 \cdot u_i \quad (4)$$
$$u_o = k_3 \cdot t_e = k_3 \cdot k_2 \cdot u_c = k_3 \cdot k_2 \cdot k_1 \cdot u_i \quad (5)$$

第一种方式为信号传播方式不变的放大过程,即图 2 中第二级 k<sub>2</sub> 的输出保持 u<sub>e</sub> 的形式和物理信号载体,在这种方式下,三级开环传输系统中信号的物理形式保持不变。另一种方式是在中间级的传输过程中使用其他信号物理形式,如图 2 中第二级 k<sub>2</sub> 的输出使用了 t<sub>e</sub> 的形式,这正是一种应用"调制 – 解调"技术的传输模型。



图 2 用于比例放大的三级开环传输系统 Fig. 2 Triple stages transform system for proportional amplify

对于第一种方式而言,由于信号的物理形式在 传输过程中没有发生改变,因此该模型适合高电压 增益的比例信号放大。但是在复杂系统芯片 (System-on-Chip,SoC)中,供电电压十分有限,并且 信号传递路径上可能存在复杂的电磁环境,信号传 递路径较长,在信号放大的中间级使用适合的信号 物理形式显得十分重要,第二种方式更为有效。

#### 2 压控频率调制

应用于电压信号和频率信号之间的信号调制 问题是一个典型的电压控制产生振荡的问题,可 以采用压控振荡器来实现。图 3(a)是典型的电 压控制振荡模型,图 3(b)是一种常见的压控环形 振荡器(Voltage Controlled Oscillator, VCO)结构, 能够将控制电压调制成为交流振荡信号<sup>[2]</sup>。相 对于差分结构的 VCO 而言,图 3 这种单端结构的 VCO 结构更为简单,并且具有更宽范围的输出频 率<sup>[3-4]</sup>,适合载波调制领域的应用。





Fig. 3 A typical model, structure and  $K_{\rm VCO}$ 

curve of voltage controlled oscillator

但是,图 3 中的典型 VCO 结构却不适合电压 信号测量领域,式(16)给出了这种环形振荡器中 单元延迟与控制电压的关系<sup>[5]</sup>,从式(16)中可见 环路的振荡频率  $\omega$  与环形振荡器的输入电压  $V_s$ 之间存在非线性的对应关系,其中  $C_{\text{load}}$ 为延迟单 元的负载电容, $\lambda$  为晶体管的沟长调制系数, $t_a$  为 单级延迟单元的延迟。同时,用于提供  $V_s$  的调整 管 MP 也是一种非线性元件,因此环路的振荡频 率  $\omega$  与 VCO 的控制电压  $u_c$  表现为复杂的高阶非 线性特性,这种高阶的非线性如图 3(c)中频率与 电压的关系曲线,其中 VCO-1 ~ VCO-5 分别为图 3(b)中的 VCO 采用不同电路参数的实现结果。

$$\frac{1}{\omega} = n \cdot t_d = n \cdot (-0.4 \cdot C_{\text{load}} \cdot \lambda \cdot V_s^2 + 0.5 \cdot \frac{C_{\text{load}}}{I_D} \cdot V_s)$$
(6)

对于信号测量而言,非线性的负面影响是显 而易见的。VCO环振中连接两级反相延迟单元 的电路节点的电压变化可以等效为 RC 电路的充 放电过程,因此用图解的方法能够非常清晰地展 现出这种非线性的形成过程。图 4 中给出了这 种非线性的关系,其中曲线  $V_{s1} \sim V_{s10}$ 表示在不同  $V_s$ 时前述节点电压随时间的变化曲线。对图 4 (a)中所有节点电压达到对应  $V_s$  的 90% 的点拟 合曲线 Cur,即为电压与周期的曲线。进一步地, 可以推演出图 4(b)中频率(1/t)与电压 V 的关系 曲线,显然这条曲线具有复杂的非线性关系。换 言之,如果用上述这种环形振荡器,仅可能在一个 很小的控制电压范围内实现"近似的"线性。

事实上,图 4(b)中的这种复杂的非线性关系 可以通过一种前馈修正技术来解决<sup>[6-7]</sup>。以图 5 中的延迟链为例, $D_0 \sim D_9$ 组成了一个由 10 级反 相延迟单元构成的延迟链,同时传输门结构的延 迟单元 T\*和 T\*\*分别对节点 C 施加来自节点 A 和节点 B 的前馈信号。节点 C 的电平翻转过程 受到节点 A 和节点 B 的修正作用,使得时间常数  $\tau$ 与充电电流的关系趋于线性化。



图 4 典型环振的"频率 – 电压"响应关系

Fig. 4 The relation curve between the frequency and voltage of the typical VCO



图 5 单环前馈结构中的信号通路 Fig. 5 The signal path in A single ring



图 6 节点 C 的 V-t 关系的线性化过程 Fig. 6 Linearity on the V-t curve at the node C

进一步地,图 6 展示了上述的线性化过程。 图 6(b)中  $C_{load}$ 为前述节点的等效负载电容, $I_c$ 为 该过程中对  $C_{load}$ 充电的电流。很显然,图 5 中节 点 A、B、C 的相位具有一定的顺序关系。对于图 5 中的主延迟链  $D_1$ 、 $D_2$ … $D_9$  而言,在没有前馈 T\* 和 T\*\*通路的情况下,A、B、C 节点均只受本级延 迟单元的控制,且相位关系如图 6(a)所示,其中 节点 A 与节点 B 的相位差为  $t_0$ ,节点 B 与节点 C 的相位差为 $t_1$ ,各个节点均按照相似的充电/放电 过程完成信号翻转。当考虑 T\*和 T\*\*前馈通路 后,如图 6(b)所示,节点 A 和节点 B 分别通过与 各自相连的传输门向节点 C 补充电流,使得节点 C 的电压处于一种超指数关系上升的状态,图 6 (c)给出了这个过程。因此,可以作出在具有前 馈电流补充的情况下的节点电压曲线如图 7(a) 所示。与图 4(a)中的 Cur 曲线对比,图 7(a)中 的 Cur 曲线具有更接近于双曲率曲线的关系,因 而"频率 - 电压"具有趋近于线性的对应关系。 这种对应关系与线性关系的逼近程度受到具体的 电路参数的影响。对于节点 C 的放电阶段,也可 以有类似的线性化过程。



图 7 节点电压的变化"频率 - 电压"响应关系 Fig. 7 The relation curve between the frequency and voltage with feedforwarding

由于"电压→频率"调制过程具有接近线性的转换关系,因此该类型的压控振荡器可以完成 图 2 中 k<sub>2</sub> 增益级的调制与信号放大功能,其增益 表现为 VCO 的增益 K<sub>vco</sub>。

#### 3 电压信号解调

相对于"电压→频率"的调制过程,将信号还 原的"频率→电压"解调也需要满足线性转换的 要求,以满足信号测量的易用性要求。常见的,基 于电容的电流积分方法可以实现频率到电压的转 换。Hung 给出了一种利用电容电荷充分配原理 的"频率→电压"转换电路,其转换电路模型如图 8 所示<sup>[8]</sup>。不妨假设开关 S<sub>0</sub> 和 S<sub>1</sub> 工作互斥,且输 入时钟的正半周开关 S<sub>0</sub> 闭合,负半周开关 S<sub>1</sub> 闭 合,则当第一次时钟正半周出现的时候,电容  $C_{o}$ 和 C<sub>1</sub> 均被充电,其后随着时钟负半周到来,电容  $C_0$ 的电量会被下拉电流源  $I_p$ 释放一部分(释放 的电量与 S<sub>1</sub> 的闭合时间相关),当随后的时钟正 半周出现时,电流源 Ic 给电容充电的同时,电容 C<sub>0</sub> 和 C<sub>1</sub> 还会通过闭合的开关 S<sub>0</sub> 进行电荷充分 配,经过多次迭代之后,电容 C<sub>1</sub> 非接地端的电位 将保持稳定。

根据 Hung 的分析,如果令充电电流  $I_c$  与放 电电流  $I_D$  相等,在经过足够长的充放电迭代之 后,图 8 中电路的输出电压  $V_O$  将满足式(7)给出 的关系,其中 N 为迭代次数,t 为时钟周期。随着 迭代次数的不断增加,输出电压将固定为式(8) 给出的结果,很显然这也是一种线性的转换关系。

$$V_0 = \frac{I_c \cdot t}{C_1} \cdot \sum_{i=1}^{N} \left( \frac{C_1}{C_1 + C_0} \right)^i$$
(7)

$$V_o = \frac{I_c \cdot t}{C_1} \tag{8}$$

#### 4 电路与仿真结果

图9是本文提出的直流电压信号放大电路



图8 基于电荷充分配的"频率→电压"转换模型 Fig.8 A "Frequency → Voltage" transformative model 整体结构。该电路由前置放大模块(PreAmplify, PA)、"电压→频率"调制模块(Interleaved Poly-Loop VCO, IPL-VCO)和"频率→电压"解调模块 (Frequency-Voltage Demodulator, F2V)组成。根 据第2节给出的技术思路,这3个模块分别完成  $k_1$ 、 $k_2$ 、 $k_3$ 3 个阶段的信号放大。

基于第3节的方法,为了满足电压信号测量 应用中对于VCO线性度的需要,同时降低对被检 测信号预处理的要求,可以构建一种利用环间前 馈耦合技术的多环自交叉VCO(IPL-VCO)。图9 (b)部分是IPL-VCO的具体结构形式,16级反相 延迟单元( $D_0$ 、 $D_1$ 、 $D_2$ … $D_{15}$ )首尾相连构成环形结 构,而其中的任意9级延迟链通过常导通传输门 结构的延迟单元( $T_0$ 、 $T_1$ 、 $T_2$ … $T_{15}$ )构成子环路,即 在整个结构中存在1个由16级反相延迟单元构 成的主环形链和16个由9级反相延迟单元和1 级传输门结构的延迟单元构成的子环形链。

在 IPL-VCO 中,任何一个连接两个反相延迟 单元的电路节点除了受到本级反相延迟单元 D\* 的作用外,还受到两路来自传输门结构延迟单元 的作用,也就构成了与图 5 中延迟链相同的结 构。根据第 3 节的分析, IPL-VCO 的"频率 - 电 压"线性度很高。图 10(a)是 65nm 工艺下实现 的 IPL-VCO 的 *K<sub>vco</sub>*曲线,在 0.8 ~ 2.0V 的电压范 围内, IPL-VCO 的"频率 - 电压"响应具有很高的 线性度。





所示。



 $(a) K_{VCO}$  curve





Fig. 10  $K_{VCO}$  of the IPL-VCO and the output of F2V

图 9(c)部分是根据第4节 Hung 提出的方法 实现的"频率→电压"解调电路 F2V。MOS 管 M5 ~ M8 构成的对称电流镜结构保证了充放电电流 的均衡。图 10(b)是该电路在3个典型输出频率 下的输出电压曲线,在经历足够长的时间之后,输 出电压可以达到稳定值,且稳定输出电压与输入 频率之间存在较为线性的对应关系。

此外,一般情况下,由于被检测的电压信号缺 乏足够的驱动能力,必须使用预放大模块 PA 进 行电压跟踪,完成前级放大,并供给 IPL-VCO 所 需的工作电流,PA 的电路结构如图 9(a)部分 图 10 中整体电路的输入输出电压情况如图 11 中曲线所示,其中纵坐标为电压值,横坐标为 测试样本,"□"为输入电压 V<sub>in</sub>,"Δ"为输出电压 V<sub>out</sub>。对输出电压 V<sub>out</sub>的拟合曲线表明,本文给出 的直流电压信号放大器能有效地实现直流电压信 号的线性放大,放大倍数可达 2.4。

从逻辑功能的角度分析,图 9 中的 3 个模块 共同实现了直流电压信号放大,逻辑上 3 个模块 具有紧密的承接关系。但从芯片内部电路的拓扑 结构来看,由于载波信号不易被干扰,因此用于 "频率(电压"解调的 F2V 模块可以远离被检测信 号,而只是将 PA、IPL-VCO 模块与被检测信号局 部化,甚至将 F2V 模块置于片外,利用片外的高 电源电压实现更大的放大倍数,并有效解决放大 过程中的噪声问题。





#### 5 结 论

直流信号的放大问题是集成电路测试中的一 个难点,传统的比例放大方法不能有效消除信号 传播路径上的干扰。本文提出了一种具有极高线 性度的直流电压信号放大电路,基于"电压→频 率→电压"的分阶段放大技术,利用频率作为信 号的载体,实现对直流电压信号的有效放大,并且 由于"电压→频率"调制过程和"频率→电压"解 调过程均具有极高的线性度,被放大的信号具有 良好的可观测性。

### 参考文献(References)

- Shao Y L, Wang Y, Ning Z H, et al. Analysis and design of high power supply rejection LDO[C]// 8th IEEE International Conference on ASIC, ASICON 2009, October 20 - 23, 2009, Changsha, China: IEEE Computer Society, 2009: 324 - 327.
- [2] Wismar U, Wisland D, Andreani P. Linearity of bulkcontrolled inverter ring VCO in weak and strong inversion [C]// NORCHIP Conference, 2005: 145-148.
- [3] 赵振宇,郭斌,张民选,等. 一款 0.18µm CMOS 辐射加固差 分压控振荡器[J]. 国防科技大学学报, 2009, 31(6):12 -17.

ZHAO Zhenyu, GUO Bin, ZHANG Minxuan, et al. A radiation-hardened-by-design differential voltage-controlled oscillator implemented in 0.18 µm CMOS process [J]. Journal of National University of Defense Technology, 2009, 31(6): 12 – 17. (in Chinese)

- [4] 赵振宇,蒋仁杰,张民选,等. 差分压控振荡器中单粒子瞬变的研究[J]. 国防科技大学学报,2009,31(2):81-85.
  ZHAO Zhenyu, JIANG Renjie, ZHANG Minxuan, et al. Research on single-event transients in differential voltagecontrolled oscillators [J]. Journal of National University of Defense Technology, 2009, 31(2):81-85. (in Chinese)
- [5] Jan M R, Borivoje N. Digital integrated circuits—A design perspective[M]. Prentice Hall, 2003.
- [6] Sun L Z, Kwasniewsk T A, A 1. 25GHz 0. 35µm monolithic CMOS PLL based on a multiphase ring oscillator[J]. Solid-

State Circuits, IEEE Journal, 2001, 36(6): 910 – 916.

- [7] Sun L Z, Kwasniewsk T A. A quadrature output voltage controlled ring oscillator based on three-stage sub-feedback loops [C]// Circuits and Systems, 1999. ISCAS'99. Proceedings of the 1999 IEEE International Symposium on, 1999,172; 176-179.
- [8] Hung T B, Yvon S. Design of a high-speed differential frequency-to-voltage converter and its application in a 5GHz frequency-locked loop[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 2008, 55(3): 766-774.
- [9] Lam Y H, Ki W H. A 0.9v 0.35m adaptively biased CMOS IDO regulator with fast transient response [J]// Proceedings of 2008 IEEE International Solid State Circuits Conference, ISSCC, Feb 3 – 7 2008, San Francisco, CA, United States, 2008: 442 – 443.
- [10] Chen H, Leung K N, A fast-transient LDO based on buffered flipped voltage follower [C]// Electron Devices and Solid-State Circuits (EDSSC), 2010 IEEE International Conference, 2010: 1-4.
- [11] Mohaned E N, Ahmed A. A 25mA 0. 13µm CMOS LDO regulator with power-supply rejection better than -56dB up to 10MHz using a feedforward ripple-cancellation technique
   [C]// IEEE International Solid-State Circuits Conference. ISSCC 2009. 2009: 330 331,331a.
- [12] Xu G, Jiang J G, Wang J K. A wide range high power supply rejection ratio and transient enhanced low drop-out regulator [C]// 6th International Conference on Wireless Communications Networking and Mobile Computing (WiCOM), 2010: 1-4.